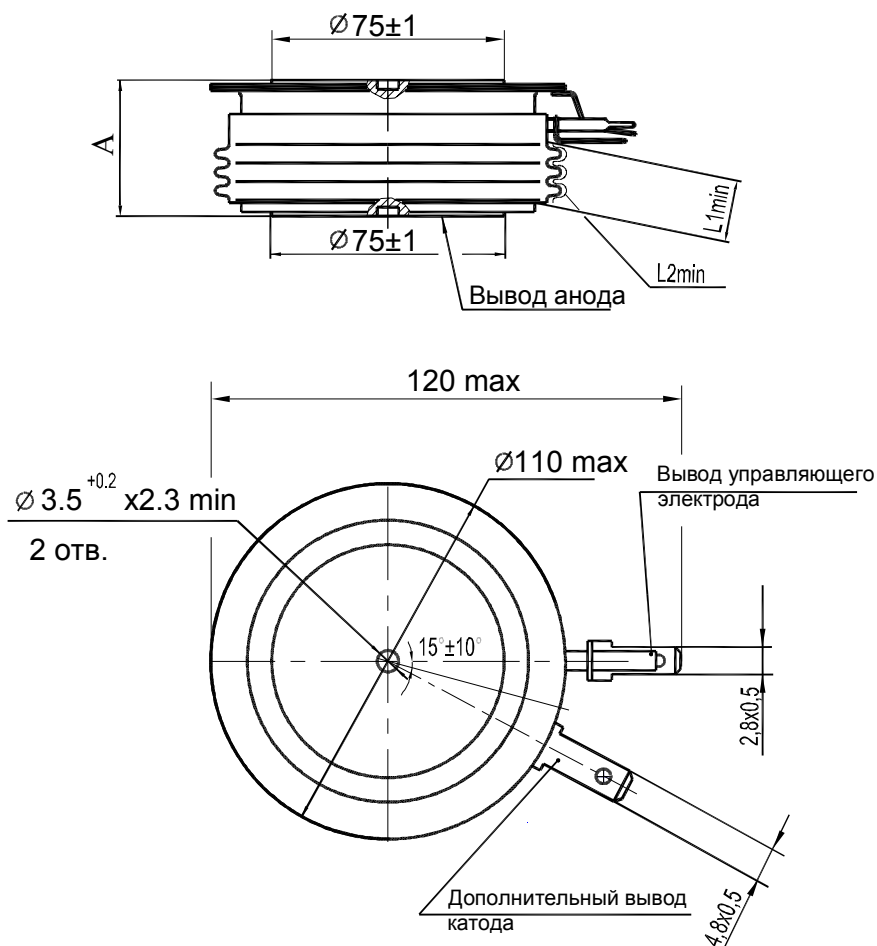


ТИРИСТОРЫ

T273-1600, T273-2000, T273-2500

T673-1600, T673-2000, T673-2500



Тип тиристора	Размеры, мм			Масса, г, не более	Усилие сжатия, Н
	A	L1 _{min}	L2 _{min}		
T273-1600, T273-2000, T273-2500	26,0 $\pm$ 2	12	21,7	1200	47500 $\pm$ 2500
T673-1600, T673-2000, T673-2500	26,0 ⁺³				

L1 - расстояние по воздуху между анодом и управляющим электродом;
L2 - длина пути для тока утечки между анодом и управляющим электродом;
Количество ребер не регламентируется.

Параметры закрытого состояния

Параметр		Значение параметра			Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	Тип тиристора			
		T273-1600 T673-1600	T273-2000 T673-2000	T273-2500 T673-2500	
U _{DRM} U _{RRM}	Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32	 - - - - 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200	 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 - -	 1200 1400 1600 1800 - - - - - - -	T _j = 25 °C T _{jm} = 140 °C Импульсы напряжения синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс, частотой 50 Гц. Цепь управления разомкнута
U _{DSM} U _{RSM}	Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34	 - - - - 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600	 1300 1500 1700 1900 2200 2400 2600 2800 3000 - - -	 1300 1500 1700 1900 - - - - - - - -	T _j = 25 °C T _{jm} = 140 °C Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью 10 мс. Цепь управления разомкнута
U _{DWM} U _{RWM}	Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В	0,8 U _{DRM} 0,8 U _{RRM}			T _j = 25 °C; T _{jm} = 140 °C Импульсы напряжения синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс, частотой 50 Гц. Цепь управления разомкнута
U _D U _R	Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В	0,6 U _{DRM} 0,6 U _{RRM}			T _c = 85 °C
$\left(\frac{du_n}{dt}\right)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не менее, для группы: 6 7 8	500 1000 1600			T _j = T _{jm} ; U _{DM} = 0,67U _{DRM} ; t _{u min} = 200 мкс Цепь управления разомкнута
I _{DRM} I _{RRM}	Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии и повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более	8 200			T _j = 25 °C; T _{jm} = 125 °C; U _D = U _{DRM} ; U _R = U _{RRM} ; Цепь управления разомкнута

Параметры термодинамической стойкости

Параметр		Значение параметра		Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	Тип тиристора		
		T273-1600	T673-1600	
		T273-2000	T673-2000	
		T273-2500	T673-2500	
I _{c(crit)}	Ток термодинамической стойкости корпуса, кА	13	80	t _i = 5,8 мс (для T273) t _i = 8,0 мс (для T673)
I _{c(crit)} ² t	Защитный показатель термодинамической стойкости корпуса. А ² ·с	25·10 ⁶ (для T673)		

Параметры открытого состояния

Параметр		Значение параметра			Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	Тип тиристора			
		T273-1600 T673-1600	T273-2000 T673-2000	T273-2500 T673-2500	
I _{TAVM}	Максимально допустимый сред- ний прямой ток в открытом со- стоянии, А	1600	2000	2500	T _c = 85 °С Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, длитель- ностью 10 мс, частота 50 Гц
	Фактический максимально до- пустимый средний ток в откры- том состоянии, А	1810	2175 (12-22 кл) 2165 (22-28 кл)	2730	T _c = 85 °С ,T _j = T _{jm} , U _{T(ТО)} , r _T при T _j = T _{jm}
I _{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии , А	2512	3140	3925	T _c = 85 °С
I _{TSM}	Ударный ток в открытом состоя- нии, кА	37,4	49,5 (12-22 кл) 44 (24-28 кл)	60,5	T _j = 25 °С, U _R = 0
		34	45 (12-22 кл) 40 (24-28 кл)	55	T _{jm} = 125 °С, U _R = 0 Импульс тока синусоидальный однополупериодный , одиноч- ный длительностью 10 мс I _G = I _{GT} при T _j = 25 °С
U _{TM}	Импульсное напряжение в откры- том состоянии, В, не более	2,10	1,75 (12-22 кл) 2,05 (12-22 кл)	1,7	T _j = 25 °С; I _T = 3,14I _{TAVM}
U _{T(ТО)}	Пороговое напряжение в откры- том состоянии, В	1,25	1,1 (12-22 кл) 1,15 (24-28 кл)	1,05	T _j = 25 °С
		1,07	0,94 (12-22 кл) 0,98 (24-28 кл)	0,95	T _{jm} = 125 °С
r _T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм	0,160	0,105 (12-22 кл) 0,14 (24-28 кл)	0,08	T _j = 25 °С
		0,210	0,125 (12-22 кл) 0,20 (24-28 кл)	0,10	T _{jm} = 125 °С
I _H	Ток удержания, мА, не более	300			T _j = 25 °С, U _D = 12 В Цепь управления разомкнута
I _{TAV}	Средний ток в открытом состоя- нии, А	Охладитель О173 по ТУ16-2007 ИЕАЛ.432270.001ТУ, T _a = 40 °С			
		330	390 (12-22 кл) 355 (24-28 кл)	395	естественное охлаждение
		805	965 (12-22 кл) 855 (24-28 кл)	1000	принудительное охлаж., v=6 м/с

Параметры управления

Параметр		Значение параметра			Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	Тип тиристора			
		T273-1600 T673-1600	T273-2000 T673-2000	T273-2500 T673-2500	
U _{ГТ}	Отпирающее постоянное напря- жение управления, В, не более	3,0			T _j = 25 °С; U _D = 12 В
		5,0			T _{jmin} = минус 60 °С; U _D = 12 В
I _{ГТ}	Отпирающий постоянный ток управления, А, не более	0,30			T _j = 25 °С; U _D = 12 В
		0,65			T _{jmin} = минус 60 °С; U _D = 12 В
U _{ГД}	Неотпирающее постоянное на- пряжение управления, В, не менее	0,40			T _{jm} = 125 °С; U _D = 0,67U _{DRM}
I _{ГД}	Неотпирающий постоянный ток управления, мА, не менее	20,0			Напряжение источника управления -постоянное

Параметры переключения

Параметр		Значение параметра			Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	Тип тиристора			
		T273-1600 T673-1600	T273-2000 T673-2000	T273-2500 T673-2500	
$\left(\frac{di_r}{dt}\right)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс	200			$T_{jm} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U_D = 0,67\text{ }U_{DRM}$, $I_T \geq I_{TAVM}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный частотой 50 Гц.
		800			$T_{jm} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U_D = 0,67\text{ }U_{DRM}$, $I_T = 2I_{TAVM} \div 3I_{TAVM}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный частотой 1 Гц Режим цепи управления: форма - трапецеидальная; длительность импульса тока не менее 50 мкс; амплитуда - $3I_{GT}$; длительность фронта 1 мкс. Внутреннее сопро- тивление источника управления не более 30 Ом
t_{qt}	Время включения, мкс, не более	30			$T_{jm} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$; $U_D = 100\text{ В}$; $I_T = I_{TAVM}$; $I_{FG} = 3I_{GT}$; $t_G = 50\text{ мкс}$
Q_{rr}	Заряд восстановления, мкКл, не более	2900			$T_{jm} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$; $I_T = I_{TAVM}$; $t_{i\min} = 200\text{ мкс}$; $U_R = 100\text{ В}$; $\left(\frac{di}{dt}\right)_f = 5\text{ А/мкс}$
t_q	Время выключения, мкс, не более, для группы: E2 H2 K2 M2	500 400 320 -	500 400 320 250(12-22 кл)	500 400 320 250	$T_{jm} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$; $I_T = I_{TAVM}$; $t_{i\min} = 200\text{ мкс}$; $\left(\frac{di}{dt}\right)_f = 5\text{ А/мкс}$; $\frac{du_d}{dt} = 50\text{ В/мкс}$; $U_R = 100\text{ В}$; $U_{DM} = 0,67U_{DRM}$

Тепловые параметры

Параметр		Значение параметра			Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	Тип тиристора			
		T273-1600 T673-1600	T273-2000 T673-2000	T273-2500 T673-2500	
T _{jm}	Максимально допустимая температура перехода, °C	125			
T _{jmin}	Минимально допустимая температура перехода, °C	минус 60			
T _{stgm}	Максимально допустимая температура хранения, °C	50			
T _{stgmin}	Минимально допустимая температура хранения, °C	минус 60			
R _{thjc}	Тепловое сопротивление переход-корпус, °C /Вт, не более	0,009			Постоянный ток
R _{thch}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, °C /Вт, не более	0,002			
R _{thja}	Тепловое сопротивление переход-среда, °C /Вт, не более	Охладитель О173 по ТУ16-2007 ИЕАЛ.432270.001 ТУ, T _a = 40 °C			
		0,206			естественное охлаждение
		0,071			принудительное охл., v=6 м/с

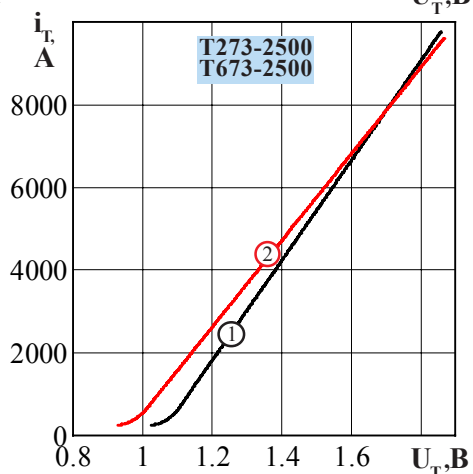
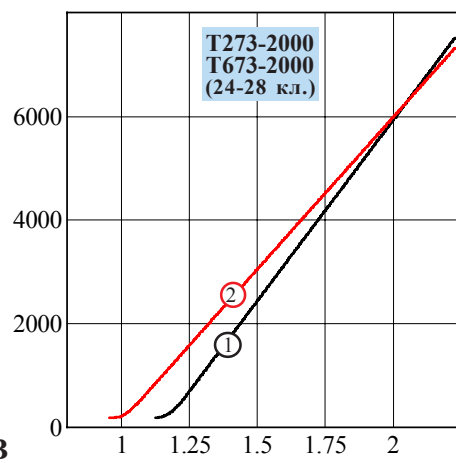
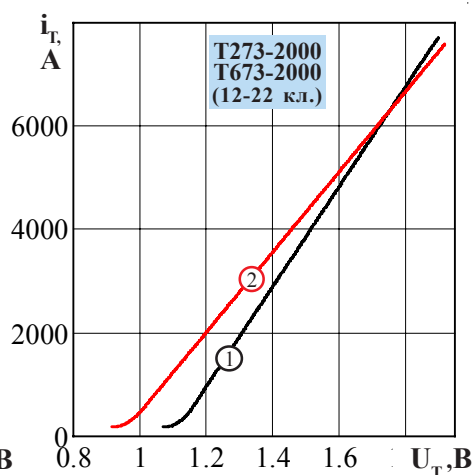
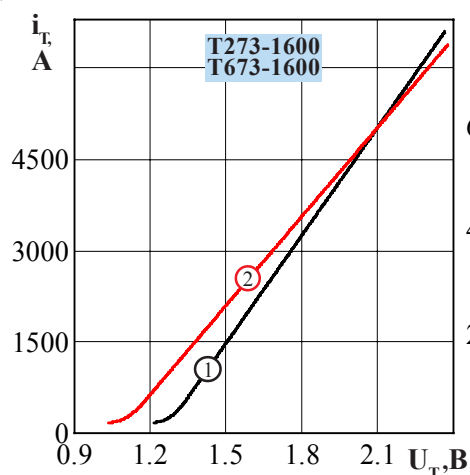


Рисунок 1 - Предельная вольтамперная характеристика в открытом состоянии при температуре перехода 25 °C (1) и максимальной температуре перехода T_{jm} (2) $I_T = 3,14I_{T(AV)}$

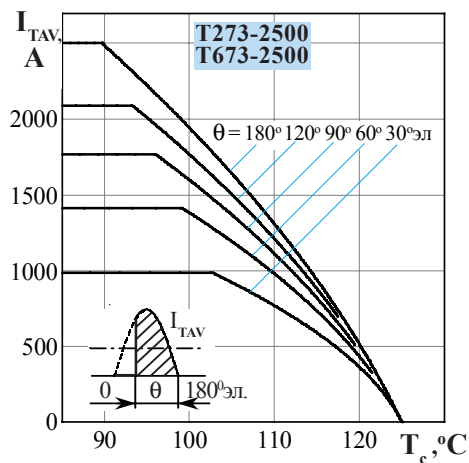
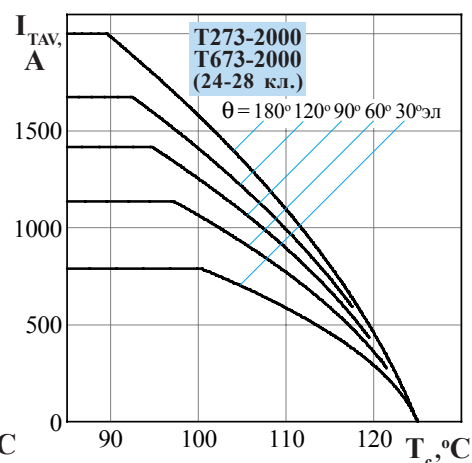
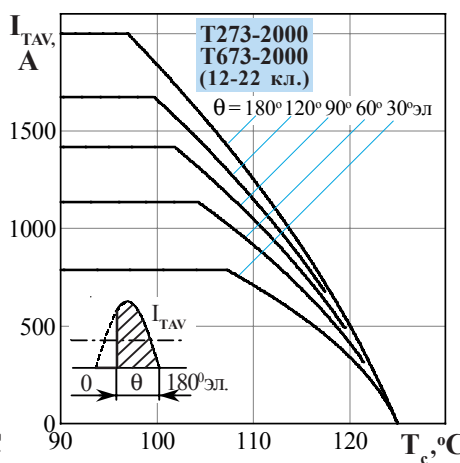
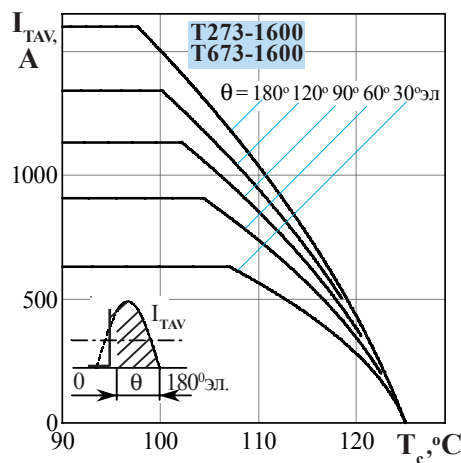


Рисунок 2 - Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии I_{TAV} от температуры корпуса T_c для токов синусоидальной формы частотой $f = 50$ Гц

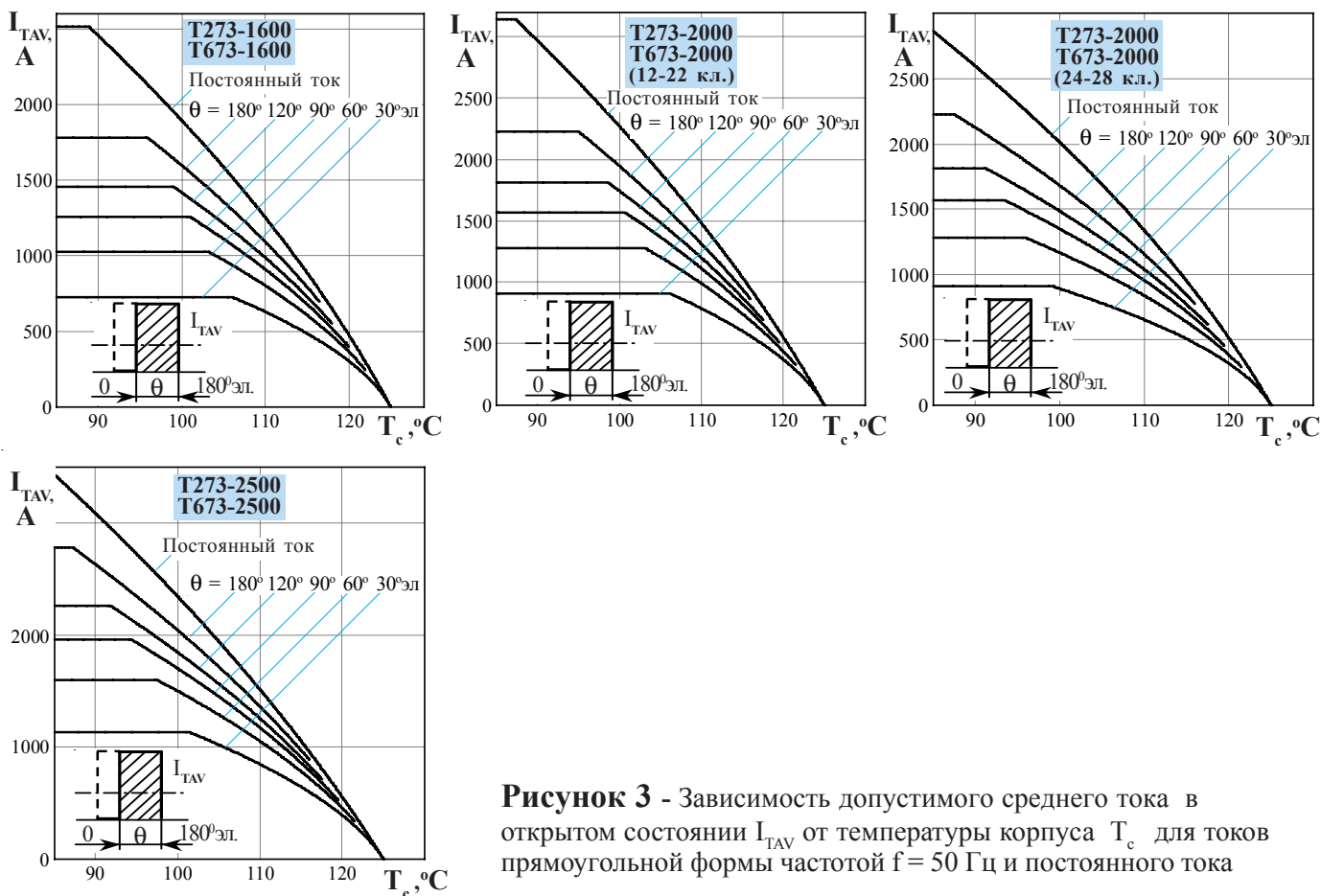


Рисунок 3 - Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии I_{TAV} от температуры корпуса T_c для токов прямоугольной формы частотой $f = 50$ Гц и постоянного тока

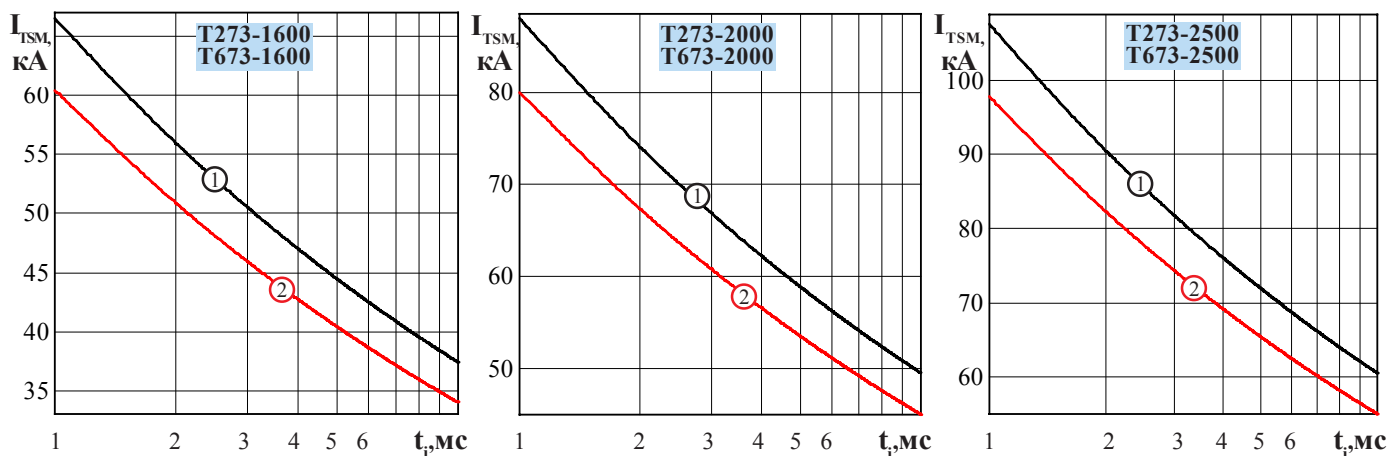


Рисунок 4 - Зависимость допустимой амплитуды ударного тока в открытом состоянии I_{TSM} от длительности импульса тока t_i при исходной температуре структуры $T_j = 25^\circ\text{C}$ (1) и максимальной температуре T_{jm} (2)

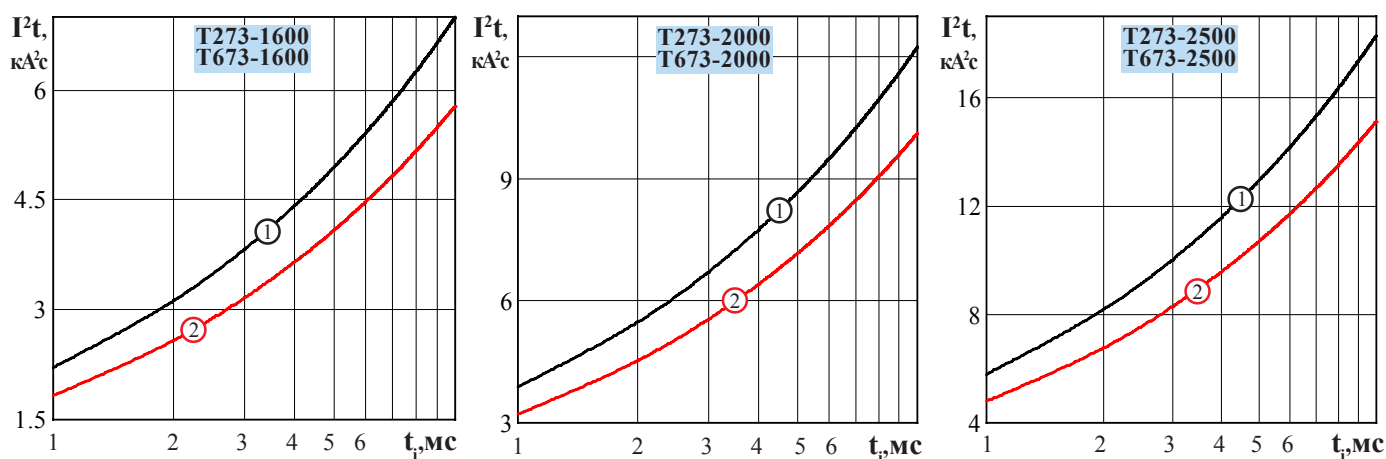


Рисунок 5 - Зависимость защитного показателя I^2t от длительности импульса тока t_p при температуре $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (1) и максимальной температуре перехода T_{jm} (2)

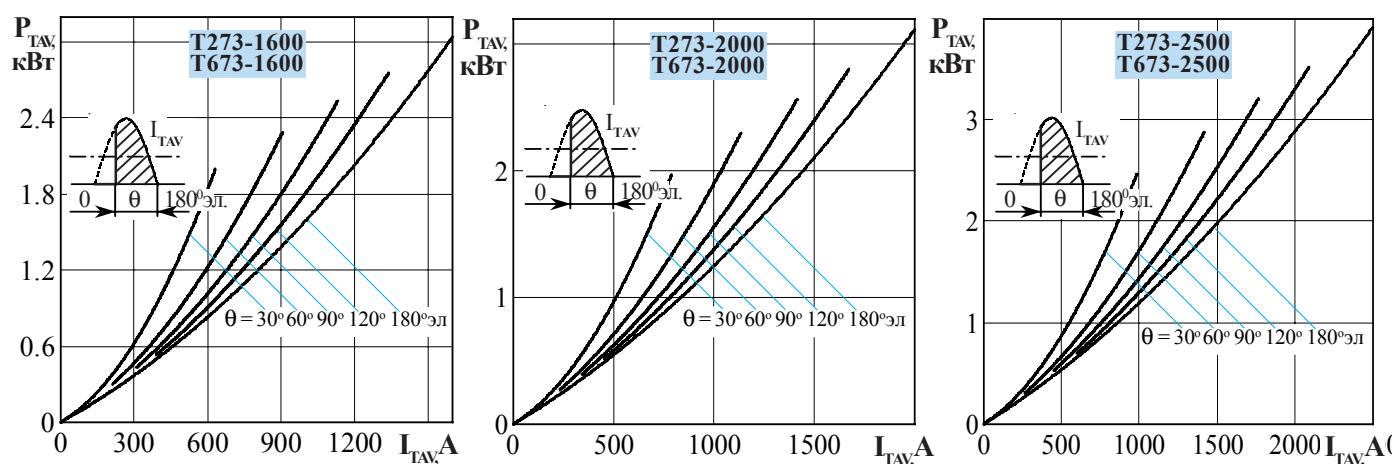


Рисунок 6 - Зависимость средней рассеиваемой мощности в открытом состоянии P_{TAV} от среднего тока в открытом состоянии I_{TAV} синусоидальной формы частотой $f = 50\text{ Гц}$

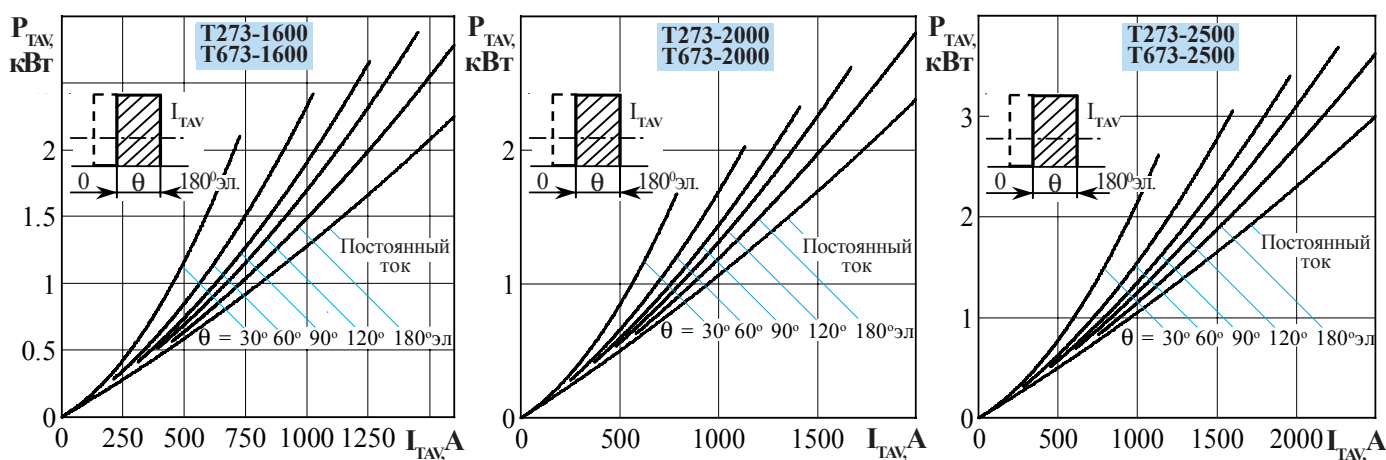


Рисунок 7 - Зависимость средней рассеиваемой мощности в открытом состоянии P_{TAV} от среднего тока в открытом состоянии I_{TAV} прямоугольной формы частотой $f = 50\text{ Гц}$ и постоянного тока

